

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM
VAZIRLIGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

Ro'yxatga olindi:
№ BD-5310800-403
" " 2019
yil



**INTEGRAL SXEMALARNI LOYIHALASH VA KONSTRUKSIYaLASH
fanining**

O'QUV DASTURI

Bilim sohasi:	300 000	- Ishlab chiqarish texnik soha
Ta'lim sohasi:	310 000	- Muhandislik ishi
Ta'lim yo'nalishi:	5310800 - 511000	Kasb talimi (Elektronika va asbobsozlik (elektronika sanoatida))

Fanning o'quv dasturi Samarqand davlat universiteti fizika fakulteti kengashida ko'rib chiqilgan va tavsiya qilingan (2019 yil "21" avgust - dagi "018"-sonli bayonnomasi).

Fakultet kengashi raisi:

dots. A.Absanov

Fan dasturi Samarqand davlat universitetida ishlab chiqildi

Tuzuvchilar:

Arziqulov E.U. Qattiq jismlar fizikasi kafedrasi dosenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Toshboyev T.U. Qattiq jismlar fizikasi kafedrasi dosenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Taqrizchilar:

Abdukarimova X.R. Qattiq jismlar fizikasi kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Rajabov R.M. Umumiy fizika va magnetizm kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Fanning dasturi Samarqand davlat universiteti o'quv-uslubiy kengashning 20 yil
"—" — dagi "—" — son majlis bayoni bilan ma'qullangan.

O'quv-uslubiy kengash raisi:

prof. A.S.Soleev

KIRISH

Ushbu dastur integral sxemalarini loyihalash va konstruksiyalash elektronika sohasida ishlataladigan o'lhash asboblari tasnifi, ularning tuzilishi va hisoblash usullari, fan tarixi va rivojining an'anasi, istiqboli xamda respublikamizdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijalari va xududi muammolarning elektronika sohasida ishlataladigan o'lhash asboblari istiqboliga ta'siri masalalarini qamraydi.

O'quv fanning maqsad va vazifalari

Fan o'qitilishidan maqsad – zamonaviy yarim o'tkazgichli asboblar, integral sxemalar va mikroelektronika texnologiyasi asoslari bo'yicha yo'naliш profiliga mos, ta'lif standartiga talab qilingan bilimlar, ko'nikmalar va tajribalar darajasini ta'minlashdir.

Fanning vazifasi – uni o'rganuvchilarga:

– talabalarga integral sxemalarini loyihalash va konstruksiyalash asoslarini, usullarini, bosqichlarini, maxsus dasturiy ta'monlardan foydalanib loyihalashni o'rgatishdan iborat.

Fan bo'yicha talabalarning tasavvur, bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablar

"Integral sxemalarini loyihalash va konstruksiyalash" fanini o'zlashtirish jarayonida talaba:

– integral sxemalarini loyihalash va konstruksiyalash asosida mikroelektron asboblarni ishlab chiqishda va tayyorlashda qo'llanaladigan texnologiyalar, texnologik jarayonlar hamda ularning elektrofizik parametrlariga, shuningdek tavsiflariga qo'yiladigan talablar *haqida tasavvurga ega bo'lishi*;

– ishlab chiqarishdagi texnalogik jarayonlarni, ularning fizik – kimyoiy asoslarini, asosiy texnalogik uslublarni, texnologik jarayonlar ketma – ketligini;

– texnologik uskunalarning asosiy turlarini integral sxema elementlarini loyihalash va konstruksiyalashni;

– elektronika soxalarida qo'llaniladigan o'lhash asboblarining optimal tavsiflarini texnik va iqtisodiy asoslangan holda to'g'ri tanlashni;

– ularning optimal ko'rsatkichlari va rejimlari asosida parametrlarini hisoblashni;

– boshqa turdag'i asboblar bilan moslashtirishni; quyilgan talablarga muvofiq sanoat tomonidan ishlab chiqarilayotgan o'lhash asboblarini tanlashni

- bunday qurilmalarda sodir bo'ladigan fizik jarayonlarni tahlil qilish, loyihalash va hisoblash usullarini *bilishi va ulardan foydalana olishi*;

– turli soxalarda qo'llaniladigan elektron zanjirlar va mikrosxemo-texnika qurilmalarini qo'yilgan talablarga binoan texnik va iqtisodiy asoslangan holda to'g'ri tanlashni;

- ularning optimal ko'rsatkichlari va rejimlarini hisoblashni; boshqa turdag'i qurilmalar bilan moslashtirishni; qo'yilgan talablarga muvofiq elektron sanoati tomonidan ishlab chiqarilayotgan mikrosxemalarni tanlashni;

– integral sxemalarini loyihalash va konstruksiyalash asosida ishlab chiqarilayotgan qurilmalarni texnik – iqtisodiy tahlil qilishni; ularni aniq sharoitlarda samarali

ishlatishni— qurilmalarning optimal ko'rsatkichlari va ish rejimlarini belgilash *ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak* ;

- boshqa turdag'i qurilmalar bilan birga ishlatish;
- integral sxemalarni loyihalash va konstruksiyalash asosida mikroprosessor qurilmalarni boshqa sxemalar bilan birgalikda ishlatish, elektron sxemalarni o'lchash va nazorat qilish *malakalariga ega bo'lishi kerak*.

Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviyligi

Integral sxemalarni loyihalash va konstruksiyalash fani asosiy ixtisoslik fanlarning biri, bu fan 7-8 – semestrarda o'qitiladi. Dasturni amalga oshirish o'quv rejasida rejalashtirilgan matematika va tabiiy-ilmiy (fizika, olyi matematika) va umumkasbiy (elektron texnika materiallari va elementlari, yarimo'tkazgichlar fizikasi) fanlardan yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlik talab etiladi.

Fanning ilm-fan va ishlab chiqarishdagi o'rni

Integral sxemalarni loyihalash va konstruksiyalash fani mikroelektronika sanoatida ishlab chiqariladigan maxsulotlarning texnologiyasini hamda texnologik qurilmalarning asosini tashkil etadi.

Shuningdek yarim o'tkazgichli asboblar va integral sxemalar ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu fan asosiy ixtisoslik fani hisoblanib, elektronika va mikroelektronika sanoat ishlab chiqarish tizimining ajralmas bo'g'inidir.

Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Talabalarning integral sxemalarni loyihalash va konstruksiyalash fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informasiy – pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallari, elektron versiyalar, virtual stendlardan foydalанилди. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda mos ravishdagi ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalанилди.

Fanning nazariy mashg'uilotlari mazmuni.

Integral sxemalarni loyihalash va konstruksiyalash fanining tarixi va rivojlanish an'analari. Shu fanda erishilgan ilm – fan, texnika va texnologiya yutuqlari. Fanni o'zlashtirishda qo'yilgan asosiy vazifalar. Yarim o'tkazgachli asbobsozlik va mikroelektronikaning hozirgi davrdagi holati va asosli rivojlanish an'analari. Integral sxemalar ishlab chiqarishda planar-epitaksial jarayonlarning umumiyligi tizimi misoldiha texnologiyaning fizik-kimyoiy asoslariga qisqacha tafsilot berish. Planar-epitaksional IMS tranzistorlarning konstruktiv texnologik xususiyatlari va uning tavsiflari. Qo'shqutbli tranzistor yarim o'tkazgichli IMS tuzilishining asosiy elementi, boshqa elementlar yaratilishidagi asos sifatida. Qo'shqutbli tranzistorlar konstruksiyasining rivojlanish tarixi. Qo'shqutbli tranzistorlar konstruktiv asoslari.

Elementlararo izolyasiya uslubini tanlashda vertikal n-p-n tranzistorlar turiga bog'liqligi. Gorizontal n-p-n tranzistorlar.

Shottki diodli tranzistorlar. Tranzistor tuzilmali asosda tuzilgan IMS diodlari va ularning konstruktiv-texnologik tavsiflari. Diodlarni konstruktiv hisoblash asoslari. Shottki diodlari. Yarim o'tkazgichli IMS larning rezistiv va sig'imli elementlari, konstruksiya turlari, tavsiflari, konstruktiv hisob asoslari. Kommutasiya elementlari, o'zaro ulashlar tizimi, konstruksiya turlari, zamonaviy KIS metallizasiysi ko'rsatkichli tizimi.

MDP – tranzistorlarining konstruktiv – texnologik xususiyatlari, integral bir qutbli tranzistorlar variantlari. Bir qutbli tranzistorlarda MDP – tranzistor IMSdag'i yagona sxema elementi sifatida, MDP-tranzistor yarim o'tkazgichli xotiraning asosiy elementi sifatida KMDP-IMS elementlari. Birlashgan ikki qutbli va bir qutbli tranzistorlardagi IMS elementlari.

Kremniyli integral mikrosxemalar ishlab chiqarishning struktura elementlari va texnologik jarayonlari

Kremniyli mikrosxemalar tayyorlashning tipik texnologik jarayoni, integral mikrosxemalar texnologiyasining o'ziga xos jihatlari.

Kremniyli tagliklarga ishlov berish.

Yarimo'tkazgichli quymalar kristallografik yo'nalishini aniqlash Kremniyyga mechanik ishlov berish, kremniy sirtini tozalash, kremniyi yemirish.

Kremniya aralashmalar diffuziyasi

Diffuzii tenglamasini yechish, diffuzantlar xarakteristikalarini, diffuziya jarayonini o'tkazishninig amaliy usullari, diffuzion qatlamlar xarakteristikalarini o'rganish usullari.

Kremniya aralashmalarni ionli kiritish

Ionli kiritishda aralashmalar taqsimoti, radiasion effektlar va ularning legirlangan qatlamlar xossalariiga ta'siri, ionlarni kiritish jarayonini o'tkazishning amaliy usullari. **Kremniy qatlamlarini epitaksial o'stirish.**

Kremniyda xloridli va silanli avtoeiitaksiya metodlari, molekulyar-nurli epitaksiya, kremniyning sapfir sirtida geteroepitaksiya, epitaksial qatlamlar xarakteristikalarini o'rganish metodlari

Yupqa pardalarni olish va ularni qayta ishlash.

Kremniy ikki oksidining pardasini termik oksidlash metodi yordamida olish, vakuumli termik changlatish, ion-plazmali changlatish, bug'—gaz aralashmalaridan yupqa pardalarni o'tqazish, pardalar qalinligini aniqlash metodlari, yupqa pardalarni qayta ishlashning ion-plazmali va plazmokimyoviy metodlari.

Litografiya

Fotolitografiya, elsktronolitografiya, rentgen nurli va ion litografi.

Kremniyli integral mikrosxemalarni tayyorlashning texnologik jarayonlari

Bipolar mikrosxemalarda elementlarni izolyasiyalash metodlari, bipolar mikrosxemalarni tayyorlashning texnologik jarayonlari, moya tranzistorlari asosida mikrosxemalarni tayyorlashning texnologik jarayonlari, elektrik ulashlarni hosil qilish va kremniyli mikrosxemalarni yig'ish.

Gibrid integral mikrosxemalarni tayyorlashning texnologik jarayonlari

Taglik materiallari, yupqa pardali mikrosxemlarda pardalar materiallari, yupqa pardalarda tasvirlar hosil qilish, yupqa pardali integral mikrosxemlar tayyorlashning tipik texnologik jarayoni, gibrid mikrosxemalarni yig'ish.

Integral mikrosxemalarni konstruksiyalashning predmeti va dastlabki ma'lumotlari

Integral mikrosxemalarni konstruksiyalash prinsiplari, integral mikrosxemalar, ularning elementlari va komponentalari, elementlar parametrlarini hisoblash masalalari.

Integral mikrosxemalar strukturlarining elektrofizik parametrlari

Integral mikrosxemalar ishchi qatlamlari, p-n o'tishlar solishtirma baryer sig'imi, p-n o'tish teshilish kuchlanishi, qatlamlar solishtirma elektr qarshiligi, emitter tokining baza qatlamida emitter qatlami bilan chegaralangan siqib chiqarish effekti (n-p-n tranzistorlar faol baza sohasi), p-n o'tishlar issiqlik toklari.

Integral yarimo'tkazgichli mikrosxemalar bipolar tranzistorlari va diodlarini loyihalash

Integral n-p-n tranzistorlar spesifikasi, n-p-n tranzistorlarni loyihalash, n-p-n tranzistor uzatish koeffisiyentini hisoblash, p-n-p tranzistorlarni loyihalash, p-n o'tishlar asosidagi integral diodlarni loyihalash, Shotki baryerli diod va tranzistorlarni loyihalash, ko'p emitterli n-p-n tranzistorlarni loyihalash.

Yarimo'tkazgichli bipolar integral mikrosxemalar passiv elementlarini loyihalash

Diffuzion kondensatorlarni loyihalash, rezistorlarni loyihalash

Mdfa mikrosxemalar elementlarini loyihalash

MDYA kondensatorlarni loyihalash, MDYA tranzistorlarni loyihalash, zaryad bog'lanishli asoboblarni loyihalash, elementlararo ulaschlarni loyihalash.

Yarimo'tkazgichli integral mikrosxemalarni loyihalash

Yarimo'tkazgichli integral mikrosxemalar topologiyini ishlab chiqish, MDYA tranzistorlar asosidagi raqamli mikrosxemalar topologiyini ishlab chiqish, chiqishida differesial kaskadi bo'lgan analogli integral mikrosxemalar topologiyasini loyihalashning o'zga xosliklari, Integral injektion mantiq, integral mikrosxemalarni konstruktiv bezash, integral mikrosxemalar hujjatlari.

Gibrid integral mikrosxemalarni loyihalash

Gibrid integral mikrosxemalarning pardali elementlarini loyihalash, gibrid integral mikrosxemalar topologiyisini ishlab chiqish.

Katta integral mikrosxemalarni loyihalash

Konstruksiyalashning o'ziga xosligi, elementlar strukturasing o'ziga xosligi, mashinada konstruksiyalash masalasi, elementlarning fiziko-topologik modeli, elementlarning matematik modellari, topologiyani mashinada yaratish, konstrukturlik hujjatlarni va fotoshablonlarni mashinada yaratish.

Galliy arsenidi asosidagi integral mikrosxemalar Galliy arsenidi asosidagi mikrosxema elementlarini tayyorlash texnologiyasi, Shottki zatvorli galliy arsenidi asosidagi maydon tranzistorlaringning elektrik va konstruktiv parametrlari.

Amaliy mashg'ulotlarning taxminiy ro'yxati

1. IMS ni optimal statik xisoblash usullari.
2. Bipolyar tranzistor parametrlarini xisoblash.
3. IMS elementlarini xisobi uchun qo'llaniladigan tranzistorning fizik strukturasi.
4. Diodlarni loyixalash va xisoblash.
5. Diffuzion rezistorlarni loyixalash va xisoblash.
6. Yarimo'tkazgichli kondensatorlarni loyixalash va xisoblash
7. MDP-tranzistorlarini ishlash prinsiplari va asosiy parametrlari.
8. Zaryad aloqali asboblarda IMS ni loyixalash .
9. GIS larni loyixalashni konstruktiv-texnologik xususiyatlari.
10. Plyonkali rezistorlarni loyixalash va xisoblash.
11. Yupqa plyonkali rezistorlarni xisoblash.
12. Murakkab konfigurasiyalri rezistorlarni xisoblash.
13. Meandr tipli rezistorlarni xisoblash.
14. Qalin plyonkali rezistorlarni xisoblash.
15. Plyonkali kondensatorlarni loyixalash va xisoblash.
16. Yupqa plyonkali kondensatorlarni xisoblash.
17. GibrildiIMS topologik strukturasini loyixalash va komponovka prinsiplari.
18. KIS larni xioblash va loyixalashni asosiy bosqichlari.

Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlarda ma'ruzalarda ko'rilgan asosiy sxemalar taxlil etiladi hamda sxemalarni loyihlash va hisoblashlarni oddiy usullari o'rganiladi. Talabalar qo'llanmalar va elektron versiyalar bilan ishlashlarni o'rganishlari kerak. Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha kafedra professor-o'qituvchilarini tomonidan ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Unda talabalar asosiy ma'ruza mavzulari bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini amaliy mashg'ulotlar orqali yanada boyitadilar. Shuningdek, darslik va o'quv qo'llanmalar asosida talabalar bilimlarini mustahkamlashga erishish, tarqatma materiallardan foydalanish, ilmiy maqolalar va tezislarni chop etish orqali talabalar bilimini oshirish, mavzular bo'yicha taqdimotlar va ko'rgazmali qurollar tayyorlash tavsiya etiladi.

Laboratoriya ishlarning taxminiy ro'yxati

1. Integral RC-filtrlarning konstruksiysi si va xarakteristikalarini o'rganish
2. Yarimo'tkazgichli integral sxema va tranzistorlarni diodli yoqilish xususiyatlari.
3. Plyonkalar parametrini nazorat usullarini o'rganish.
4. Gibrildi integral mikrosxemani konstruktiv-texnologik

- xususiyatlarini taxlil qilish.
5. Diffuzion rezistorlar.
6. Yarimo'tkazgichli mikrosxema kondensatorlari.
7. Yarimo'tkazgichli IMS larni bipolyar tranzistorlari.
8. Mikroyig'malarni xisoblash va konstrukturash.
9. Yupqa plynokalarini shakllantirish usullarini o'rganish.
10. Integral mikrosxemalarda kontaktlar yaratish usullarini o'rganish.
11. Fotolitografik jarayonni o'rganish.
12. Integral mikrosxemolarni germetizasiya qilish usullarini o'rganish.
13. Berilgan o'tkazuvchanlik turlarini yaratish usullari (diffuziya, epitaksiya, ion kirgizish(ionnoye vnedreniye)) o'rganish.
14. Plynokali integral mikrosxemalar topologiyasini o'rganish.

Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar

Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo'yicha kafedra professor-o'qituvchilarini tomonidan ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Laboratoriya ishlari talabalar yarimo'tkazgichli IMS, bipolar va maydonli tranzistorlar, shuningdek tiristorlarni tadqiqot qilish, ularning parametrlarini aniqlash va IMS topoplogiyasini o'rganish taxlil qilish bo'yicha amaliy ko'nikma va malaka xosil qildilar.

Mustaqil ta'limumning shakli va mazmuni

Talaba mustaqil ishni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini xisobga olgan holda quyidagi shakklardan foydalanishi tavsiya etiladi:

- Darslik va o'quv qo'llanmalar bo'yicha fan boblari va mavzularini o'rganish;
- Tarqatma materiallar bo'yicha ma'ruzalar qismini o'zlashtirish;
- Maxsus adabiyotlar bo'yicha fanlar bo'limlari yoki mavzulari ustida ishlash;
- Yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o'rganish;
- Talabaning o'quv-ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lgan fanlar bo'limlari va mavzularini chuqur o'rganish;
- Faol va muammoli o'qitish uslubidan foydalananiladigan o'quv mashg'ulotlari.

Mustaqil ish bajariladigan mavzular bo'yicha savolnomalar tuzish, savollarga foydalanishga tavsiya etilgan adabiyotlardan foydalangan holda yozma tarzda javob berish va boshqalar.

Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari

1. Fanning rivojlanish istiqbollarini.
2. Integral sxemalarning sinflari.
3. Integral sxemalarni loyihalash usullari.
4. Katta integral sxemalarni loyihalash usullari.
5. O'ta katta integral sxemalarni loyihalash usullari.
6. Integral sxemalarni loyihalashda ishlataladigan dasturiy ta'minotlar.
7. Integral sxemalarni loyihalashning asosiy bosqichlari.
8. Mantiqiy integral sxemalarni loyihalash usullari.

9. IMS ni ishlab chiqish bosqichlari, konstruktorlik xujjatlarini tarkibi va ularni rasmiylashtirish qoidalari.
10. KMDP tipidagi komplementar tranzistorli struktura.
11. MDYa strukturali unipolyar (maydonli) tranzistor konstruksiyasi.
12. Yarimo'tkazgichli IMS li integral diodlar konstruksiyasi.
13. IMS dielektrik podloj-kalarining asosiy parametrlarini nazorat qilish usullari.
14. Mantiqiy integral sxemalarni loyihalash usullari.
15. Keramik ko'pqatlamli qalin pylonkali plata asosidagi GIS konstruksiyalari va tayyorlash texnologiyalari.
16. Yarimo'tkazgichli mikro-sxema kondensatorlarining konstruksiyasi.
17. Yarimo'tkazgichli plastina parametrlarini nazorat qilish usullari.
18. Pylonkali kondensatorlar konstruksiyasi.
19. Pylonkali induktiv elementlar konstruksiyasi.
20. Qalin pylonkalarni tayyorlash qurilmalari.
21. Yarimo'tkazgichli rezistorlarni konstruksiyasi va texnologiyasi.
22. Yupqa qatlamli rezistorlarni tayyorlash uchun qo'llaniladigan materiallarning xususiyatlari
23. Qalin pylonkali GIS i MSB konstruksiyasi va ishlab chiqarish texnologiyasi.

DASTURNING INFORMASION-USLUBIY TA'MINOTI

Mazkur fanni o'kitish jarayonida ta'limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot – kommunikasiya texnologiyalari qo'llanilishi nazarda tutulgan.

Fanni o'zlashtirishda masofadan o'qitish, darslik, o'quv qo'llanmalarini va ma'ruzalar matnlarining elektron versiyalaridan, ma'lumotlar elektron bazasidan, kompyuter jo'rligida ma'ruzalar o'qish, elektron plakatlar va virtual laboratoriya ishlaridan foydalaniлади, amaliy mashg'ulotlarda kichik guruxlar musobaqlari, guruhli fikrlash pedagogik texnologiyalarni qo'llash nazarda tutiladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:
Asosiy adabiyotlar:

1. Kurnosov A.I., Yudin V.V. Texnologiya proizvodstva poluprovodnikovых priborov i integralnykh mikrosxem. Uchebnik. – M.: Radio i svyaz, 1996
2. Ayupov Q.S., Iliyev X.M. "Yarimo'tkazgichli asboblar va integral sxemalar texnologiyasi" fanidan ma'ruzalar to'plami. - T: TDTU, 1999
3. Jigalskiy A.A. Proyektirovaniye i konstruirovaniye mikrosxem: Uchebnoye posobiye. - Tomsk: TUSUR, 2007
4. Pichugin I.G., Tairov Yu.M. Texnologiya poluprovodnikovых priborov. Uchebnik. -M.: Vysshaya shkola, 1994
5. Berezin A.S., Mochalkina O.R. Texnologiya i konstruirovaniye integralnykh mikrosxem. Uchebnik. - Radio i svyaz, 2002, 320 s.
6. Jigalskiy A.A. Proyektirovaniye i konstruirovaniye mikrosxem: Uchebnoye posobiye. - Tomsk: TUSUR, 2007. - 195 s.
7. Mayzda F. Integralnyye sxemy i ix primeneniya. Izdatelstvo "Mir" 2001

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Iliyev X.M. «Texnologiya poluprovodnikovых priborov i integralnykh sxem». Metodicheskiye ukazaniya k laboratornym rabotam.- Tashkent, TGTU, 2004
2. Berezin A.S., Mochalkina O.R. Texnologiya i konstruirovaniye integralnykh mikrosxem.Uchebnoye posobiye.-M.: Radio i svyaz, 1993
3. Gil U., Lakson Dj. Integralnyye mikrosxemy. Materialy. Pribory. Izgotovleniye. Per. s ang. pod red. M.V. Galperina. Uchebnik. –M.: Mir, 1998
4. Vaysburd F.I. Elektronika. Polnyy kurs leksiy. – SPb.: KORONA PRINT, 2004
5. Baxodirxonov M.K., Iliyev X.M.«Yarim o'tkazgichli asboblar va integral sxemalar texnologiyasi kursiga oid atamalar». –Toshkent: TDTU,2004

Internet saytlari:

1. www.zivonet.uz
2. <http://avnsite.narod.ru/physic/pp/index.htm>
3. <http://www.ad.ugatu.ac.ru/knbase/content.htm>
4. [www.zivonet.uz;](http://www.zivonet.uz)
5. [www.lex.uz;](http://www.lex.uz)
6. [www.bilim.uz;](http://www.bilim.uz)
7. [www.gov.uz.](http://www.gov.uz)